

SOT223 NPN SILICON PLANAR MEDIUM POWER TRANSISTOR

ISSUE 3- FEBRUARY 1995

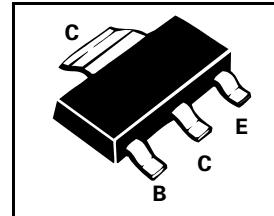
FEATURES

- * Low saturation voltage

COMPLEMENTARY TYPE - FZT757

PARTMARKING DETAIL - FZT657

FZT657



ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	300	V
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	300	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	5	V
Peak Pulse Current	I_{CM}	1	A
Continuous Collector Current	I_C	0.5	A
Power Dissipation at $T_{amb}=25^\circ\text{C}$	P_{tot}	2	W
Operating and Storage Temperature Range	$T_i; T_{stg}$	-55 to +150	°C

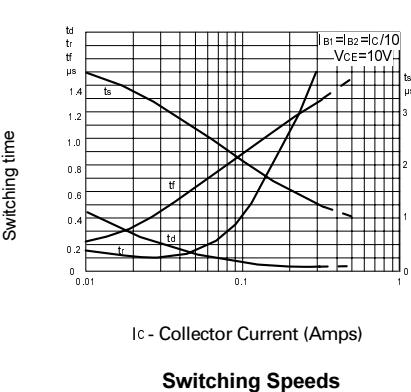
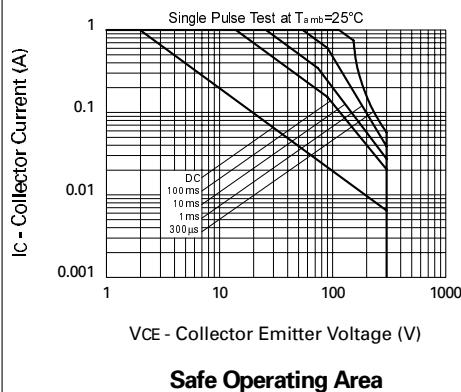
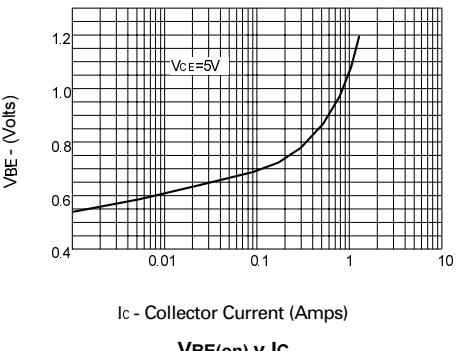
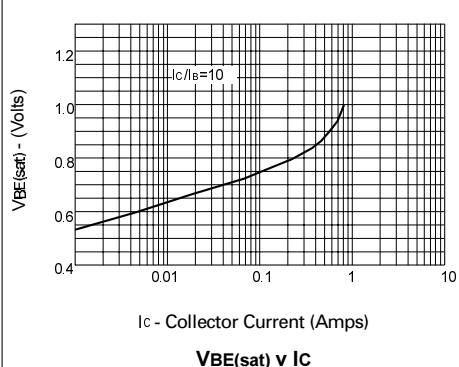
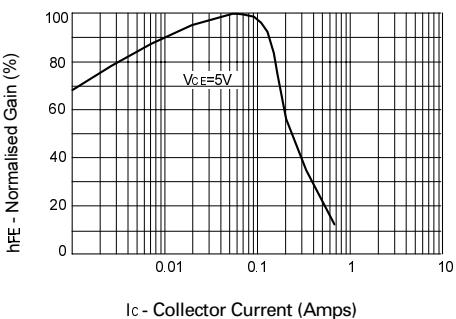
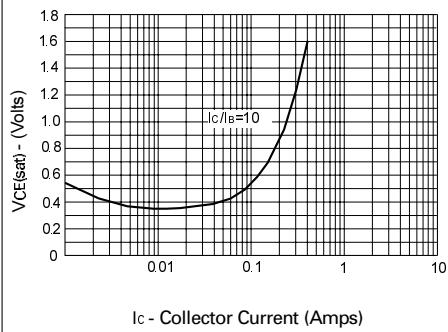
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise stated).

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Collector-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)CBO}$	300			V	$I_C=100\mu\text{A}$
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$V_{(BR)CEO}$	300			V	$I_C=10\text{mA}^*$
Emitter-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)EBO}$	5			V	$I_E=100\mu\text{A}$
Collector Cut-Off Current	I_{CBO}			0.1	μA	$V_{CB}=200\text{V}$
Emitter Cut-Off Current	I_{EBO}			0.1	μA	$V_{EB}=3\text{V}$
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(\text{sat})}$			0.5	V	$I_C=100\text{mA}, I_B=10\text{mA}^*$
Base-Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(\text{sat})}$			1.0	V	$I_C=100\text{mA}, I_B=10\text{mA}^*$
Base-Emitter Turn-On Voltage	$V_{BE(\text{on})}$			1.0	V	$I_C=100\text{mA}, V_{CE}=5\text{V}^*$
Static Forward Current Transfer Ratio	h_{FE}	40 50				$I_C=10\text{mA}, V_{CE}=5\text{V}^*$ $I_C=100\text{mA}, V_{CE}=5\text{V}^*$
Transition Frequency	f_T	30			MHz	$I_C=10\text{mA}, V_{CE}=20\text{V}$ $f=20\text{MHz}$
Output Capacitance	C_{obo}			20	pF	$V_{CB}=20\text{V}, f=1\text{MHz}$

*Measured under pulsed conditions. Pulse Width=300μs. Duty cycle ≤2%
Spice parameter data is available upon request for this device

FZT657

TYPICAL CHARACTERISTICS





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помошь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помошь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.